## ВЛИЯНИЕ ИНТЕРКАЛЯЦИИ НА РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TlinS<sub>2</sub><Ge>

### Р.М.САРДАРЛЫ, О.А.САМЕДОВ, И.Ш.САДЫХОВ, Э.А.ЗЕЙНАЛОВА, А.П.АБДУЛЛАЕВ

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана AZ1143, г.Баку, ул.Ф.Агаева, 9

Изучены диэлектрические и поляризационные свойства интеркалированного серебром соединения  $TlInS_2 < Ge>$ . Установлено, что при интеркаляции расширяется температурная область существования релаксорного состояния. В направлении оси c интеркалированного серебром соединения  $TlInS_2 < Ge>$  обнаружено появление спонтанной поляризации, отсутствующее в неинтеркалированных кристаллах, и оценено ее максимальное значение  $0.7 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{Kn/cm}^2$ .

В настоящее время слоистые соединения привлекают к себе внимание благодаря их исключительным свойствам. К этим свойствам прежде всего можно отнести максимальную анизотропию их диэлектрических и электрических характеристик, обусловленную спецификой кристаллической структуры слоистых Благодаря анизотропии кристаллы соединений. этого класса открывают возможность для исследования наиболее интересных эффектов физики твердого тела в их двумерном проявлении. Замечательно, что анизотропия слоистых быть значительно усилена соединений может или ослаблена интеркалировании.

Как известно, при интеркалировании слоистых кристаллов интеркалянт может проникать в ван-дер-ваальсовские щели в двух видах: в атомном виде (не связанном жестко с решеткой) или же в виде ячеек роста (жестко связанных с решеткой) [1]. Так в работе [1] показано, что кривые ЯМР, снятые на примесях <sup>7</sup>Li в SnTe, напоминают структуру и форму ЯМР поглощения Li в жидкости. Это указывает на то, что литий движется так же, как и в жидкости, а не занимает определенного положения равновесия. В этом смысле состояние интеркалированного лития аналогично состоянию жидкости. Отсюда был сделан вывод о том, что атомы лития не связаны жестко с решеткой кристалла SnTe.

Теллур, внедряемый в монокристаллы InSe методом диффузии [2], становится акцепторной примесью, однако, при интеркаляции теллуром степень анизотропии кристаллов InSe уменьшается. Авторы связывают это с образованием ковалентных мостиков между слоями при внедрении атомов теллура, т.е. теллур входит в InSe в виде ячеек роста.

Интеркалирование GaSe атомами Li, Na и K приводило к образованию в образце поляризационного состояния в направлении оси c, которое зависело от сорта вводимой примеси и характера ее распределения [3]. Это состояние сохранялось длительное время.

Образование поляризации при интеркаляции также наблюдалось в кристалле InSe при внедрении ионов  $Na^+$  [2]. Показано, что для не интеркалированного InSe рассеяние носителей заряда происходит на неполярных оптических фононах, а для образцов, интеркалированных ионами  $Na^+$ , при 105К происходит переход от рассеяния на неполярных оптических фононах к рассеянию на полярных фононах. Эти перемены авторы объясняли поляризацией кристаллической решетки InSe при интеркалировании ионов натрия.

Слоистые кристаллы семейства  $A^3B^3C_2^6$  фото-и рентгеночувствительны, оптически активны. Эти свойства оказались сильно чувствительны к процессам интеркаляции [4.5.6].

В имеющихся у нас литературных источниках не было обнаружено работ, связанных с исследованиями влияния интеркаляции на диэлектрические свойства кристаллов  $A^3B^3C_2^6$ .

Интеркаляция соединения TlInS<sub>2</sub><Ge> осуществлялась методом тянущего электрического поля [7,8]. В качестве интеркалянта были выбраны ионы серебра, которые позволяют реализовывать эффективную интеркаляцию образцов без их разрушения. Ширина Ван-дер-Ваальсовой щели равна ≈3Å, тогда как ионный радиус Ag равен  $r_{Ag}=1,28$ Å.

Монокристаллы TlInS<sub>2</sub><Ge> представляли собой прямоугольные параллелепипеды, имеющий верхний металлический электрод. Их помещали в стеклянную ячейку с интеркалянтом таким образом, чтобы нижняя грань образца соприкасалась с поверхностью 0.1N водного раствора AgNO<sub>3</sub>. В ячейке под нижней гранью монокристаллов, находился графитовый электрод. К данной системе прикладывалось внешнее электрическое поле напряженностью 200В/см..

Недавно нами было показано, что соединение TlInS<sub>2</sub><Ge> относится к классу сегнетоэлектриков [9-11]. Настоящая же работа посвящена исследованию влияния интеркаляции серебром на диэлектрические свойства релаксорного сегнетоэлектрика TlInS<sub>2</sub><Ge>.

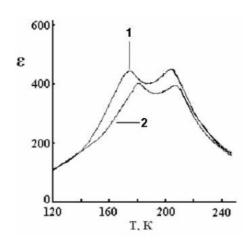


Рис.1.

- 0,1атм.% (нагрев). Частота измерительного Ge - 0,1атм.%. Измерения выполнены на частоте поля кривой 1 - 1к $\Gamma$ ц, кривой 2 - 1м $\Gamma$ ц.

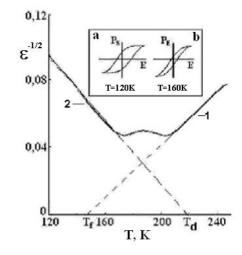
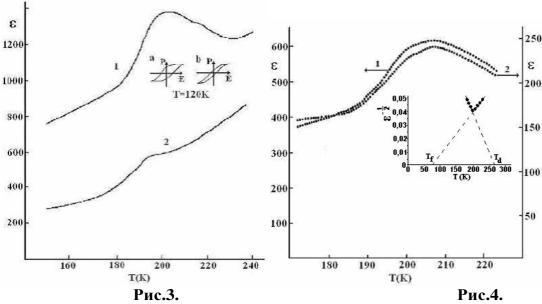


Рис.2.

Зависимости  $\varepsilon(T)$  кристалла  $TIInS_2 < Ge>$ , где Ge Зависимость  $\varepsilon^{-1/2}$  для соединения  $TIInS_2 < Ge>$ , где 1мГц. На вставке к рисунку приводятся петли диэлектрического гистерезиса: а – при 120К; b – при 160К.

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости ε(Τ) при частоте 1кГц и 1МГц для соединения TlInS2<Ge> приведена на Рис.1. Как видно из рис.1 (кривая 1), в неинтеркалированном кристалле наблюдаются два максимума в температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε(Τ) температурах  $T_{m1}$ =173К и  $T_{m2}$ =205К. При этом зависимость  $\epsilon(T)$  кристаллов TlInS<sub>2</sub><Ge> (0,1 мол.% Ge) сильно размыта, расширяется область существования несоразмерной фазы с сохранением двух аномалий при  $T_{m1}$ =173К ( $\Delta T_{m1}$ =7К) и  $T_{m2}$ =205К ( $\Delta T_{m2}$ =2К) с увеличением частоты измерительного поля от 1 кГц до 1 МГц (Рис.1, кривые 1 и 2).

Важной особенностью сегнетоэлектриков с размытыми фазовыми переходами является то, что в этих соединениях не выполняется закон Кюри-Вейса, а линейный участок наблюдается при зависимости  $\varepsilon^{-1/2} \sim (T-T_0)$ . Как видно из Рис.2 (кривая 1),  $\varepsilon^{-1/2}(T)$  со стороны высокотемпературной фазы пересекает температурную ось при 144К. Эта температура соответствует температуре Фогеля-Фулчера, т.е. выше этой температуры система переходит в состояние сегнетоэлектрического стекла. Кривая  $\varepsilon^{-1/2}(T)$  со стороны низкотемпературной фазы пересекает температурную ось при температуре  $T_d$ =220К (Рис.2, кривая 2, температура Бернса  $T_d$ ). Показано, что в этом кристалле температурная область существования релаксорного состояния ( $T_d$ - $T_f$ =76К) наиболее широка по сравнению с другими релаксорами, полученными на основе соединения  $TIInS_2$ .



Зависимости  $\varepsilon(T)$  интеркалированного серебром кристалла  $TIInS_2 < Ge>$ , снятые на частоте  $1\kappa\Gamma$ ц: кривая 1—вдоль оси c, кривая 2— перпендикулярно оси c. На вставке к рис. приводятся петли диэлектрического гистерезиса: кривая а —перпендикулярно оси c, кривая b —вдоль оси c при120К.

Зависимости  $\varepsilon(T)$  интеркалированного серебром кристалла  $TIInS_2 < Ge>$ , снятые на частоте  $1M\Gamma$ ц. На вставке к рисунку приводятся зависимости  $\varepsilon^{-1/2}$ , снятые перпендикулярно оси с.

На Рис.3 и Рис.4 приведены температурные зависимости диэлектрической проницаемости интеркалированного серебром кристалла  $TIInS_2 < Ge >$ измеренные на частоте 1к $\Gamma$ ц и 1М $\Gamma$ ц,соответственно, перпендикулярно оси c (кривые 1) и параллельно оси c (кривые 2).

Полученные по диэлектрическим измерениям результаты показывают, что диэлектрическая проницаемость интеркалированных кристаллов по оси cотносительно увеличивается В несколько раз исходного соединения. неинтеркалированных кристаллах TlInS<sub>2</sub><Ge> петли диэлектрического гистерезиса по оси c не наблюдаются, так как спонтанная поляризация направлена по оси (100). В интеркалированном же кристалле  $TIInS_2 < Ge > по оси <math>c$  появляется петля гистерезиса (Рис.3, вставка b). Максимальное значение спонтанной поляризации при этом составляет  $0.7 \cdot 10^{-8}$  Кл/см<sup>2</sup>. В то же время по оси (100) интеркалированного спонтанная поляризация уменьшается относительно соединения примерно в 3,5 раза.

Из сравнения Рис.3. и Рис.4. видно, что при увеличении частоты измерительного поля с  $1\kappa\Gamma$ ц до  $1M\Gamma$ ц максимальное значение  $\epsilon(T)$  смещается в сторону более высоких температур  $\left[T_{\rm m}\left(M\Gamma u\right)-T_{\rm m}\left(\kappa\Gamma u\right)=\Delta T_{\rm m}\right]$  вдоль слоев  $\Delta T_{\rm m}=5$  К

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРКАЛЯЦИИ НА РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TllnS<sub>2</sub><Ge>

перпендикулярно слоям  $\Delta T_m$ =11К. Максимальное значение диэлектрической проницаемости при 1МГц, по сравнению с 1кГц сильно уменьшается как в направлении слоев  $\frac{\mathcal{E}(\kappa \Gamma \mu)}{\mathcal{E}(M\Gamma \mu)}$ =2,85, так и перпендикулярно им  $\frac{\mathcal{E}(\kappa \Gamma \mu)}{\mathcal{E}(M\Gamma \mu)}$ =2,5, а сам фазовый

переход сильно размывается. На вставке к Рис.3 также приведены петли диэлектрического гистерезиса, снятые перпендикулярно оси c (a) и параллельно оси c (b).

Таким образом, интеркаляция серебром кристалла  $TIInS_2 < Ge >$  приводит к возникновению петель диэлектрического гистерезиса в температурной области существования устойчивого релаксорного состояния при приложении поля вдоль оси с. Как известно, в этой геометрии в неинтеркалированных кристаллах  $TIInS_2 < Ge >$ , поляризация отсутствует. Учитывая вышесказанное можно сказать, что серебро скорее всего связывается со слоями кристалла  $TIInS_2 < Ge >$  и, по аналогии со слоистыми кристаллами семейства  $A^3B^6$ , образует ковалентные мостики между слоями, что и является причиной возникновения наблюдаемых особенностей.

- 1. К.Ф.Товстюк, Полупроводниковое материаловедение, Киев, Наукова Думка, 1984, 264.
- 2. З.Д.Ковалюк, П.И.Савицкий, К.Д.Товстюк, *Неорганические материалы*, **28** (1982) 209.
- 3. И.В.Минтянский, И.И.Григорчак, З.Д.Ковалюк, С.В.Гаврилю, *ФТТ*, **28** (1986) 1263.
- 4. С.Н.Мустафаева, М.М.Асадов, В.А.Рамазанзаде, *Неорганические материалы*, **31** (1995) 318.
- 5. С.Н.Мустафаева, Э.М.Керимова, Н.З.Гасанов, *ФТП*, **32** (1998) 145.
- 6. Г.Д.Гусейнов, С.Н.Мустафаева, Неорганические материалы, 25 (1989) 150.
- 7. G.Scholz, P.Joensen, J.M.Reyes and R.F.Frindt, Физическая электроника, №22 (1981) 181.
- 8. И.И.Григорчак, З.Д.Ковалюк, С.П.Юрценюк, Физическая электроника, №22 (1981) 181.
- 9. O.A.Samedov, Azerbaijan National Transaction of Azerbaijan Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical sciences, Physics and Astronomy, XXIII №2 (2003) 60.
- 10. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, И.Ш. Садыхов, *Неорганические материалы*, **40** (2004) 1163.
- 11. R.M. Sardarli, O.A. Samedov, I.Sh. Sadykhov, 2<sup>th</sup> International conference on technical and physical problems in power engeneering, Tabriz-Iran, (2004) 394.

#### TIInS2<Ge> KRİSTALININ RELAKSOR XASSƏLƏRİNƏ İNTERKALYASİYANIN TƏSİRİ

#### R.M.SƏRDARLI, O.Ə.SƏMƏDOV, İ.Ş.SADIQOV, E.A.ZEYNALOVA, A.P.ABDULLAYEV

Gümüşlə interkalyasiya olunmuş  $TIInS_2$ <Ge> birləşməsinin dielektrik və polyarizasiya xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Ag-lə interkalyasiya olunmuş birləşmədə relaksor halının mövcud olma temperatur oblastı genişlənir və interkalyasiya olunmuş  $TIInS_2$ <Ge> birləşməsində c oxu istiqamətində polyarizasiya yaranır və onun maksimal qiyməti  $P_s \approx 0.7 \cdot 10^{-8} KI/sm^2$  müəyyən edilmişdir.

# INFLUENCE OF INTERCALATION ON TIInS<sub>2</sub><Ge> CRYSTALS RELAXOR PROPERTIES R.M.SARDARLY, O.A.SAMEDOV, I.S.SADIGOV, E.A.ZEJNALOVA, A.P.ABDULLAEV

Dielectric and polarizing properties of silver intercalated  $TIInS_2 < Ge>$  connection have been investigated. It was established, that intercalation extend the temperature area of relaxor conditions. In c axis a direction of silver intercalated  $TIInS_2 < Ge>$  connection spontaneous polarization occurrence which revealed and its maximal value appreciated as  $0.7 \cdot 10^{-8}$   $CI/cm^2$ .

Редактор: Дж.Абдинов